

Micron和Intel合作，以高性能封装叠加内存解决方案 增强Knights Landing

为下一代计算提供低功耗、带宽极高 的内存解决方案

爱达荷州博伊西，2014年6月24日（GLOBE NEWSWIRE） -- 世界领先的先进半导体解决方案供应商之一，Micron Technology, Inc.（纳斯达克股票代码：MU）今日宣布与Intel合作，为Intel下一代Xeon Phi(TM)处理器提供封装叠加内存解决方案，其研发代码为Knights Landing。该内存解决方案是这两家公司为了冲破内存壁垒的长期合作成果，其采用了基本的DRAM和堆叠技术，后者也被Micron混合内存立方产品使用。

“生态系统正在改变，可扩展封装叠加内存和内存带宽的重要性已变得众所周知，” IDC调研经理Chirag Dekate说到。“内存是解决方案的核心，大计算和大数据都将从中受益匪浅。此次产品发布清晰地说明了Micron是如何推动内存存在系统中的作用和影响，以及3D内存的价值。”

该内存的持续内存带宽达到DDR4的5倍，每比特能耗仅为其三分之一，占用面积仅为其一半，Knights Landing高性能封装叠加内存将高速逻辑和DRAM层合并到一个经优化的封装中，将为性能和能耗设置新的行业标杆。内存堆叠优化了可靠性、可用性和可服务性，这是高性能计算系统的关键因素。Knights Landing系统的首次应用之一 -- 下一代Cray XC超级计算机 -- 于4月29日由NERSC推出。

“Intel的多集成核心（MIC）结构加上Micron的高性能内存是一种强大的组合，” Micron计算和网络事业部副总裁Tom Eby说到。“Intel和Micron的先进技术成功地将处理器嫁接到内存系统，该内存系统非常罕见地将低功耗和超大带宽相结合。”

“下一代Intel(R) Xeon Phi(TM)处理器，研发代码为Knights Landing，其发布时将具备16GB高性能封装叠加内存，其持续内存带宽比DDR4大幅度提高，带来极高的能源利用率并极大节省空间。这是第一款使用这种新型高性能封装叠加内存的Intel HPC处理器，” Intel工作站和高性能计算数据中心集团副总裁兼总经理Charles Wuischpard说到。“这将使全球顶尖的研究人员、科学家和工程师能够更加快速地运行更大的工作负载，同时只需维持当前的代码投资。能与Micron合作交付这种内存，我们深感荣幸。”

欲知更多Micron管理的高性能内存解决方案详情，请访问 <http://www.micron.com/products/hybrid-memory-cube>。

关于Micron

Micron Technology, Inc. 是全球领先的先进半导体解决方案供应商之一。通过它遍布全球的运营，Micron为先进的计算、用户、网络、嵌入式和移动产品生产和销售全套DRAM、NAND和 NOR闪存，以及其他创新的存储器技术、封装方案和半导体系统。Micron的普通股在纳斯达克上市交易，代码是MU。欲了解有关Micron Technology, Inc. 的更多信息，请访问www.micron.com。

(c)2014 Micron Technology, Inc. 版权所有。资料若有修改，恕不另行通知。Micron和Micron orbit徽标为Micron Technology, Inc. 商标。其他商标分别为其各自所有者财产。本新闻稿包含有关高性能封装叠加内存可用性的前瞻性陈述。实际情况或结果可能与前瞻性陈述中包括的内容不同。请参考Micron和证券交易委员会定期发布的汇总文件，特别是Micron最新的10-K和10-Q表。这些文件包含并确定导致汇总文件中的内容与前瞻性陈述不同的重要因素（见“某些因素”）。尽管我们认为前瞻性陈述中所反映的预期是合理的，但我们不能保证其未来结果、活动程度、性能或成就。

联系方式：公共关系联系方式：

Greg Wood
Zeno Group for Micron Technology
650-801-7958
Greg.Wood@zenogroup.com